## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА

УДК 537.638.5

# ВЛИЯНИЕ ФЕРРОМАГНИТНОГО ОБМЕНА И ОРИЕНТАЦИИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА МАГНИТОКАЛОРИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В ОДНООСНОМ ВАН-ФЛЕКОВСКОМ ПАРАМАГНЕТИКЕ

© 2019 г. Е. Е. Кокорина<sup>а, \*</sup>, М. В. Медведев<sup>а, \*\*</sup>

<sup>а</sup>Институт электрофизики УрО РАН, 620016 Россия, Екатеринбург, ул. Амундсена, 106

\*e-mail: kokorina@iep.uran.ru \*\*e-mail: medvedev@iep.uran.ru Поступила в редакцию 18.06.2018 г. После доработки 31.07.2018 г. Принята к публикации 17.09.2018 г.

Исследован магнитокалорический эффект (МКЭ) – изменение магнитной энтропии при изотермическом намагничивании – в одноосном ван-флековском парамагнетике со спином S = 1 и одноионной анизотропией типа легкая плоскость. Показано, что при намагничивании в легкой плоскости величина нормального МКЭ (уменьшение энтропии при намагничивании) может быть аномально велико в тех случаях, когда соотношение параметров анизотропии и ферромагнитного обмена в парамагнетике будет близко к пороговому значению, после которого происходит переход в ферромагнитное состояние. Установлено, что при намагничивании в трудном направлении, перпендикулярно легкой плоскости, МКЭ при низких температурах имеет аномальный характер – магнитная энтропия увеличивается при намагничивании.

Ключевые слова: магнитокалорический эффект, ван-флековский парамегнетик

DOI: 10.1134/S0015323019030070

#### I

Магнитокалорические эффекты (МКЭ) в парамагнетиках ланжевеновского типа максимальны вблизи температуры абсолютного нуля, что дало возможность эффективно использовать эти соединения в процессах получения сверхнизких температур [1–4]. С физической точки зрения это

связано с тем, что магнитная восприимчивость  $\chi^L$  ланжевеновского парамагнетика расходится как  $1/T \to \infty$  при температуре  $T \to 0$ , стремящийся к нулю. Соответственно этому МКЭ, связанный с изменением магнитной энтропии при изотермическом намагничивании и пропорциональный температурной производной  $d\chi^L/dT$ , будет вести себя как  $1/T^2 \to -\infty$  при  $T \to 0$ .

Интересно сравнить низкотемпературное поведение МКЭ ланжевеновского парамагнетика с МКЭ поляризационного ван-флековского парамагнетика, у которых температурная зависимость магнитной восприимчивости  $\chi^{VV}$  очень слаба, поскольку основное состояние магнитных ионов ван-флековского парамагнетика является синглетным [5]. В работе [6] исследован МКЭ в модели одноосного ван-флековского парамагнетика для некрамеровских ионов с целочисленными спинами S = 1, 2, ..., находящимися в кристаллическом поле типа легкая плоскость, причем был обнаружен обратный МКЭ в низкотемпературной области при намагничивании в трудном направлении. Однако рассмотрнная в [6] модель ван-флековского парамагнетика применима только для гидратированных парамагнитных солей, где магнитные моменты d- или f-ионов разделены молекулами кристаллизационной воды и поэтому не связаны между собой обменным взаимодействием. В более обшем случае между магнитными ионами существует обменная связь, однако основное синглетное состояние ван-флековского парамагнетика будет сохраняться до тех пор, пока отношение параметров обмена и одноионной анизотропии типа легкая плоскость не превысит порогового значения. Поэтому цель настоящей работы состоит в том, чтобы понять, как наличие обменного взаимодействия повлияет на МКЭ ван-флековского парамагнетика.

### Π

Рассмотрим сначала случай, когда внешнее магнитное поле *Н* приложено в плоскости легко-

го намагничивания (*H*||*OX*) одноосного ван-флековского парамагнетика. Исходный гамильтониан имеет вид:

$$H_{\parallel} = D \sum_{n} S_{Z}^{2}(n) - \frac{1}{2} J \sum_{n} \sum_{\Delta=1}^{z} S(n) S(n + \Delta) - \mu_{0} H \sum_{n} S_{X}(n),$$
(1)

где D > 0 — параметр одноионной анизотропии типа легкая плоскость,  $\mu_0 = g\mu_B$  ( $\mu_B$  — магнетон Бора, g — фактор Ланде) и обменное взаимодействие учтено в приближении ближайших соседей (J > 0 — ферромагнитный параметр обмена, z число ближайших магнитных соседей). Считаем, что S = 1 — целочисленный некрамерсов спин, так что в отсутствие обмена (J = 0) и внешнего поля (H = 0) каждый ион находится в синглетном основном состоянии. В приближении молекулярного поля гамильтониан  $H_{\parallel}$  (1) преобразуется к сумме одноузельных спин-гамильтонианов:

$$H_{\parallel}^{MFA} = \sum_{n} H_{\parallel}(n)^{MFA};$$

$$H_{\parallel}(n)^{MFA} = H_{0,\parallel} + DS_{z}^{2}(n) - h_{X}S_{X}(n),$$
(2)

где введены обозначения:

$$h_{X} = \mu_{0}H + J_{Z}\sigma_{X}; \quad H_{0,\parallel} = \frac{1}{2}J_{Z}\sigma_{X}^{2};$$

$$\sigma_{X} \equiv \langle S_{X}(n) \rangle =$$

$$= Sp \left[ S_{X}e^{-\beta H_{\parallel}^{MFA}(n)} \right] / Sp \left[ e^{-\beta H_{\parallel}^{MFA}(n)} \right];$$

$$\beta = 1/k_{B}T.$$
(3)

С помощью  $H_{\parallel}(n)^{MFA}$  (2) легко получить самосогласованное уравнение для термодинамического среднего значения *X*-проекции спина  $\sigma_X$  (при S = 1):

$$\sigma_{\chi} = \frac{4h_{\chi} \mathrm{sh} \left(\beta \sqrt{D^{2} + 4h_{\chi}^{2}} / 2\right)}{\sqrt{D^{2} + 4h_{\chi}^{2}} \left[ \exp(-\beta D / 2) + 2\mathrm{ch} \left(\beta \sqrt{D^{2} + 4h_{\chi}^{2}} / 2\right) \right]}.$$
(4)

Это уравнение позволяет найти соотношение параметров анизотропии D и обмена Jz, определяющее область существования синглетного состояния исследуемого магнетика при T = 0.

Для этого предположим, что в отсутствие внешнего поля H = 0 в магнетике существует спонтанный ферромагнетизм вдоль оси *OX* в плоскости легкого намагничивания с параметром порядка  $\sigma_X(H = 0, T) \equiv \sigma_{X_0}(T)$ . Тогда в пределе  $T \to 0$  из уравнения (4) найдем

$$\sigma_{X_0}(T=0) = \sqrt{1 - \left(\frac{D}{2Jz}\right)^2}.$$
 (5)

С другой стороны, линеаризуя правую часть (4) в пределе бесконечно малого параметра  $\sigma_X(T) \rightarrow 0$ , можно получить линейное уравнение для определения температуры Кюри  $T_{C_X}$ , при которой возникает спонтанный ферромагнетизм вдоль оси ОХ. Эта температура Кюри  $T_{C_X}$  равна

$$k_{\rm B}T_{\rm C_X} = \frac{D}{\ln\left|\frac{2Jz + 2D}{2Jz - D}\right|}.$$
 (6)

Тогда из (5) и (6) можно получить известный результат (см., например, [7]), что и  $\sigma_{X_0}(T = 0)$  (5), и точка Кюри  $T_{C_X}$  (6) одновременно исчезают, когда параметр обмена *J* уменьшается до критического значения

$$(2Jz)_{\rm crit} = D. \tag{7}$$

Таким образом, при T = 0 спонтанный ферромагнетизм существует только при условии  $2J_z > D$ , а при  $2J_z < D$  возникает область ван-флековского парамагнетизма с синглетным основным состоянием магнитных ионов. Поэтому дальше будем исследовать изотермическое намагничивание ван-флековского парамагнетика с ограничением  $2J_z < D$  на энергетические параметры взаимодействий.

Если к одноосному ван-флековскому парамагнетику приложить магнитное поле  $H \parallel OX$  в плоскости легкого намагничивания, то на каждом узле магнитной решетки индуцируется намагниченность  $m_X = \mu_0 \sigma_X$ . Для невысоких полей, в линейном приближении по полю H, можно выразить поляризационную намагниченность из формулы (4) через линейную магнитную восприимчивость  $\chi_X^{VV}$ :

$$m_{X} = \mu_{0}\sigma_{X} \approx \chi_{X}^{VV}H =$$

$$= \frac{2\mu_{0}^{2}}{\left[\frac{\exp(D/k_{\rm B}T) + 2}{\exp(D/k_{\rm B}T) - 1}\right]D - 2Jz}H.$$
(8)

Для низких температур ( $D \gg k_{\rm B}T$ ) из (8) следу-

ет, что низкотемпературная восприимчивость  $\chi_X^{W}$  фактически не зависит от температуры *T*, так как температурные поправки к значению восприим-

чивости  $\chi_X^{VV}(T=0)$  при нулевой температуре

$$\chi_X^{VV}(T=0) = 2\mu_0^2 / (D - 2Jz)$$
 (9)

будут экспоненциально малы

$$\chi_X^{VV}(D \gg k_{\rm B}T) \cong$$
$$\equiv \chi_X^{VV}(T=0) \left[ 1 - \frac{3D}{D - 2Jz} \exp\left(-\frac{D}{k_{\rm B}T}\right) \right].$$
(10)

Однако важно отметить, что абсолютная величина  $\chi_X^{VV}(T=0)$  существенно зависит от величины разности  $D - 2J_Z$ , отражающей степень близости ван-флековского парамагнитного состояния к границе перехода в феромагнитное состояние и что на границе перехода (по соотношению параметров взаимодействия) восприимчивость  $\chi_X^{VV}(T=0)$  расходится

$$\lim \chi_X^{VV}(T=0) \to \infty \text{ при } D \to 2Jz + 0^+.$$
(11)

Для области высоких температур ( $D \ll k_{\rm B}T$ ) восприимчивость ван-флековского парамагнетика носит кюри-вейссовский характер:

$$\chi_{X}^{VV}(D \ll k_{\rm B}T) = \frac{(2/3)\mu_{0}^{2}}{k_{\rm B}(T - \theta_{pX})},$$
  

$$\theta_{pX} = \frac{1}{3} \left(\frac{D}{2} + 2Jz\right) > 0,$$
(12)

причем положительная парамагнитная точка Кюри  $\theta_{pX}$  включает вклады как от ферромагнитного обмена, так и от кристаллического поля.

Выражение  $m_X$  (8) позволяет найти температурную производную  $\partial m_X(T, H)/\partial T$  и с ее помощью найти МКЭ, описывающий изменение магнитной энтропии ван-флековского парамагнетика  $\Delta S_M^{VV}(T, H \parallel OX)$  (на один магнитный атом) при изотермическом намагничивании от нулевого начального поля  $H_i = 0$  до конечного поля  $H_f$  [1–3]

$$\Delta S_{M}^{VV}(T, H_{f} \| OX) =$$

$$= \int_{0}^{H_{f}} \left( \frac{\partial m_{X}(T, H)}{\partial T} \right)_{H} dH = (13)$$

$$2 D^{2} \operatorname{end} (D(H, T)) = (U, H)^{2}$$

$$= -k_{\rm B} \frac{3D^2 \exp(D/k_{\rm B}T)}{\left[(D - 2Jz)\exp(D/k_{\rm B}T) + 2(D + Jz)\right]^2} \left(\frac{\mu_0 H_f}{k_{\rm B}T}\right)$$

Для низких температур $D \ge k_{\rm B}T$  выражение (13) преобразуется к виду

$$\Delta S_{M}^{VV}(T, H_{f} \| OX) / k_{\rm B} \approx$$

$$\approx -3 \left( \frac{D}{D - 2Jz} \right)^{2} \exp(-D/k_{\rm B}T) \times \qquad (14)$$

$$\times \left( \frac{\mu_{0}H_{f}}{k_{\rm B}T} \right)^{2} < 0,$$



**Рис. 1.** Зависимость изменения магнитной энтропии  $\Delta S_M^{VV}(T, H_f || OX)$  от безразмерной температуры  $k_{\rm B}T/D$  при намагничивании в легкой плоскости от начального поля  $H_i = 0$  до конечного поля  $H_f$  для следующих вариантов отношений параметров обмена и анизотропии: 2Jz/D = 0 – кривая 1; 2Jz/D = 0.5 – кривая 2; 2Jz/D = 0.9 – кривая 3 и 2Jz/D = 0.99 – кривая 4. Конечное поле в безразмерных единицах выбрано  $\mu_0 H_f/D = 1$ . Следует обратить внимание, что для изменения магнитной энтропии  $\Delta S_M^{VV}$  используется логарифмическая шкала.

а при высоких температурах  $D \ll k_{\rm B}T$  приближенно равно

$$\Delta S_{M}^{VV}(T, H_{f} \| OX) / k_{\rm B} \approx \approx -\frac{1}{3} \left( 1 + \frac{D + 4Jz}{3k_{\rm B}T} \right) \left( \frac{\mu_{0}H_{f}}{k_{\rm B}T} \right)^{2} < 0.$$
<sup>(15)</sup>

Таким образом, в противоположность ланжевеновскому парамагнетику, в котором  $\Delta S_M^L(T, H_f)$ расходится при  $T \to 0$ , в ван-флековском парамагнетике изменение энтропии  $\Delta S_M^{VV}(T, H_f || OX)$  стремится к нулю при  $T \to 0$ . Поэтому заметной величины изменения энтропии  $\Delta S_M^{VV}(T, H_f || OX)$  в низкотемпературной области можно ожидать лишь в ван-флековских парамагнетиках, близких к границе перехода в спонтанное ферромагнитное состояние при  $D \to 2J_Z + 0^+$ .

На рис. 1 представлено поведение изменения энтропии  $\Delta S_M^{VV}(T, H_f || OX)$  (13) как функции безразмерной температуры  $k_B T/D$  при изотермическом намагничивании от начального нулевого поля до конечного  $H_f$ , безразмерная величина которого задана условием  $\mu_0 H_f/D = 1$ . При этом исследовано 4 варианта отношений параметров обмена  $J_Z$  и анизотропии D, а именно:  $2J_Z/D = 0$ ; 0.5; 0.9 и 0.99. Видно, что величина  $\Delta S_M^{VV}(T, H_f || OX) < 0$  –

ФИЗИКА МЕТАЛЛОВ И МЕТАЛЛОВЕДЕНИЕ том 120 № 3 2019

отрицательна (нормальный МКЭ) и что максимальная абсолютная величина эффекта резко возрастает при уменьшении разности  $D - 2J_z$ , сдвигаясь в сторону более низких температур. Этот результат согласуется с расходимостью изменения энтропии  $\Delta S_M^{VV}(T, H_f || OX) \rightarrow -\infty$  при  $D \rightarrow 2J_z$ , т.е. с приближением состояния ван-флековского парамагнетика к границе перехода в ферромагнитное состояние по мере изменения энергетических параметров системы.

#### Ш

Теперь исследуем изменение магнитной энтропии ван-флековского парамагнетика  $\Delta S_M^{VV}$  $(T, H_f \| OZ)$  в случае изотермического намагничивания в трудном направлении вдоль оси OZ, перпендикулярной плоскости легкого намагничивания OXY. Учитывая наличие ферромагнитного обмена J > 0 и появление в магнитном поле  $H \| OZ$  индуцируемых магнитных моментов на узлах  $m_Z(n)$ , в приближении молекулярного поля эту ситуацию можно описать одноузельным гамильтонианом  $H_{\perp}^{MFA}(n)$ :

$$H_{\perp}^{MFA}(n) = E_{0,\perp} + DS_Z^2(n) - h_Z S_Z(n),$$
(16)

где обозначено

$$E_{0,\perp} = \frac{1}{2} J_Z \sigma_Z^2, \quad h_Z = \mu_0 H + J_Z \sigma_Z, \qquad (17)$$
$$\sigma_Z \equiv \langle S_Z(n) \rangle.$$

Для спина S = 1 термодинамическое среднее значение Z-проекции спина  $\sigma_Z \equiv \langle S_Z(n) \rangle$  определяется уравнением

$$\sigma_{Z} = \frac{2\mathrm{sh}[\beta(\mu_{0}H + Jz\sigma_{Z})]}{\mathrm{exp}(\beta D) + 2\mathrm{ch}[\beta(\mu_{0}H + Jz\sigma_{Z})]}.$$
 (18)

Тогда в линейном приближении по магнитному полю *H* намагниченность узла  $m_Z(n)$  выражается из (18) через восприимчивость  $\chi_Z^{VV}(T)$  [7] как

$$m_{Z} = \mu_{0}\sigma_{Z} \approx \chi_{Z}^{\nu\nu} H =$$
  
=  $\frac{2\mu_{0}^{2}}{k_{\rm B}T[2 + \exp(D/k_{\rm B}T)] - 2Jz} H.$  (19)

Теперь, в отличие от случая намагничивания в легком направлении с  $\chi_X^{VV}$  (9) и (10), низкотемпературная магнитная восприимчивость ( $D \gg k_{\rm B}T$ ) стремится к нулю:

$$\chi_Z^{VV}(D \ge k_{\rm B}T) \approx \frac{2\mu_0^2}{k_{\rm B}T} \exp(-D/k_{\rm B}T) \to 0, \qquad (20)$$
$$T \to 0.$$

Высокотемпературная магнитная восприимчивость ( $D \ll k_{\rm B}T$ ) ван-флековского парамагнетика вдоль трудного направления намагничивания, как и в случае намагничивания в легком направлении, имеет кюри-вейссовский вид. Однако парамагнитная точка Кюри  $\Theta_{pZ}$  теперь будет отрицательна:

$$\chi_{Z}^{VV}(D \ll k_{\rm B}T) = \frac{(2/3)\mu_0^2}{k_{\rm B}(T - \Theta_{pZ})};$$

$$\Theta_{pZ} = -\frac{1}{3}(D - 2Jz) < 0.$$
(21)

Используя (19), находим, что температурная производная  $\partial m_Z / \partial T$  равна

$$\frac{\partial m_Z}{\partial T} = k_B 2 \frac{(\exp(D/k_B T) [(D/k_B T) - 1] - 2)}{(k_B T [2 + \exp(D/k_B T)] - 2Jz)^2} \mu_0^2 H_f.$$
(22)

Тогда изменение магнитной энтропии при намагничивании в трудном направлении ( $H \parallel OZ$ ) от  $H_i = 0$  до  $H_f$  имеет вид

$$\Delta S_{M}^{VV}(T, H_{f} \| OZ) =$$

$$= k_{\rm B} \frac{(\exp(D/k_{\rm B}T)[(D/k_{\rm B}T) - 1] - 2)}{(k_{\rm B}T[2 + \exp(D/k_{\rm B}T)] - 2Jz)^{2}} (\mu_{0}H_{f})^{2}.$$
(23)

В области низких температур ( $D \gg k_{\rm B}T$ ) это изменение положительно

$$\Delta S_{M}^{VV}(T, H_{f} \| OZ) / k_{\rm B} \approx \approx \left(\frac{D}{k_{\rm B}T}\right) \exp(-D/k_{\rm B}T) \left(\frac{\mu_{0}H_{f}}{k_{\rm B}T}\right)^{2} > 0, \qquad (24)$$

а при высоких температурах ( $D \ll k_{\rm B}T$ ) будет отрицательным

$$\Delta S_{M}^{VV}(T, H_{f} \| OZ) / k_{\rm B} \approx -\frac{1}{3} \left[ 1 - \frac{2(D-2J_{Z})}{3k_{\rm B}T} \right] \left( \frac{\mu_{0}H_{f}}{k_{\rm B}T} \right)^{2} < 0.$$
<sup>(25)</sup>

Из (23) следует, что смена знака изменения магнитной энтропии определяется условием

$$\exp(D/k_{\rm B}T)[(D/k_{\rm B}T) - 1] - 2 = 0.$$
(26)

Тогда из (26) получаем, что при температурах  $k_{\rm B}T/D < 0.683$  будет наблюдаться аномальный (обратный) МКЭ – рост магнитной энтропии при изотермическом намагничивании  $\Delta S_M^{VV}(T, H_f || OZ)$ , а при  $k_{\rm B}T/D > 0.683$  будет реализовываться нормальный (прямой) МКЭ с  $\Delta S_M^{VV}(T, H_f || OZ) < 0$ .

На рис. 2 приведены расчеты температурной зависимости величины изменения энтропии  $\Delta S_M^{VV}(T, H_f \| OZ)$  при изотермическом намагничи-

вании в трудном направлении от нулевого начального поля  $H_i = 0$  до конечного поля  $H_f$ . Величина конечного поля  $H_f$  в безразмерных единицах, как и в случае намагничивания в легком направлении, выбрана как  $\mu_0 H_f / D = 1$ . Результаты расчетов представлены для двух крайних вариантов отношения параметров обмена и анизотропии: для 2Jz/D = 0 (кривая I) – случая отсутствия ферромагнитного обмена и для 2Jz/D = 0.99 (кривая 2) – случая близости отношения параметров к критическому значению, отвечающему границе перехода в ферромагитное состояние.

Видно, что различие в величине  $\Delta S_M^{VV}$ ( $T, H_f \| OZ$ ) между этими крайними вариантами отношения 2Jz/D незначительно. Аналогичные кривые для  $\Delta S_M^{VV}(T, H_f \| OZ)$  при выборе какихлибо промежуточных отношений параметров 2Jz/D из интервала 0 < 2Jz/D < 1 лежат между этими двумя кривыми, и поэтому они не приведены на рисунке. Кроме того, видно, что в низкотемпературной области при  $k_{\rm B}T/D < 0.683$  наблюдается аномальный МКЭ – намагничивание увеличивает энтропию ( $\Delta S_M^{VV}(T, H_f \| OZ) > 0$ ), тогда как при  $k_{\rm B}T/D > 0.683$  при намагничивании энтропия уменьшается.

Наконец, если сравнить теперь абсолютные значения величин  $|\Delta S_M^{VV}(T)|$  в точках экстремумов на кривых температурных зависимостей для намагничивания в легком (рис. 1) и трудном (рис. 2) направлениях, то можно заметить, что абсолютные величины эффектов в максимумах для этих двух вариантов намагничивания сопоставимы только при очень слабом обмене  $2J_Z/D \ll 1$ . Однако в случае близости ван-флековского парамагнитного состояния к границе перехода в ферромагнитное состояние (т.е. при  $2J_Z/D \cong 1$ ) абсолютная величина нормального МКЭ при намагничивании в легкой плоскости будет на 2–3 порядка больше, чем абсолютная величина аномального МКЭ при изотермическом намагничивании в трудном направлении.

#### IV

Мы показали, что в одноосном ван-флековском парамагнетике с некрамерсовыми спинами S = 1 и одноионной анизотропией типа легкая плоскость МКЭ (изменение магнитной энтропии при изотермическом намагничивании  $\Delta S_M^{VV}(T, H)$ ) наиболее интересен в низкотемпературной области  $k_{\rm B}T < D$ , в которой характер и величина эффекта радикально отличаются при намагничивании в легком и трудном направлениях. При намагничивании в легком направлении (в легкой плоскости вдоль



**Рис. 2.** Температурная зависимость изменения магнитной энтропии  $\Delta S_M^{VV}(T, H_f || OZ)$  при намагничивании в трудном направлении от нулевого начального поля  $H_i = 0$  до конечного поля  $\mu_0 H_f / D = 1$ .. Кривая 1 - для случая 2Jz/D = 0 (отсутствие ферромагнитного обмена); кривая 2 - для случая 2Jz/D = 0.99 (случай близости ван-флековского парамагнетика к границе перехода в ферромагнитное состояние).

оси ОХ) МКЭ имеет нормальный характер, так как  $\Delta S_M^{VV}(T, H_f || OX) < 0$  и магнитная энтропия уменьшается при намагничивании. При этом абсолютная величина эффекта  $|\Delta S_M^{VV}(T)|$  при заданной температуре *T* сильно зависит от соотношения между энергетическими параметрами анизотропии *D* и ферромагнитного обмена *Jz*, достигая аномально больших величин при увеличении *Jz* до пороговых значений (*Jz*)<sub>сгіт</sub> = *D*, отвечающих границе перехода в ферромагнитное состояние.

При намагничивании в трудном направлении, перпендикулярно плоскости легкого намагничивания ( $H \| OZ$ ), МКЭ в низкотемпературной области  $k_{\rm B}T < 0.683D$  носит аномальный характер, так как  $\Delta S_M^{VV}(T, H_f \| OZ) > 0$  и магнитная энтропия растет при намагничивании. Однако при этом изменение соотношения между параметрами  $J_Z$  и D мало влияет на величину эффектов  $\Delta S_M^{VV}(T, H_f \| OZ)$ , температурное поведение которых практически зависит только от отношения  $k_{\rm B}T/D$ .

Наконец, в области температур  $k_{\rm B}T > D$  намагничивание и в легком, и в трудном направлениях дают нормальные МКЭ, хотя даже в пределе очень высоких температур  $k_{\rm B}T \gg D$  намагничивание в легком направлении дает несколько большие значения эффекта  $|\Delta S_M^{VV}(T, H_f || OX)| > |\Delta S_M^{VV}(T, H_f || OZ)|.$ 

Работа выполнена в рамках темы государственного задания № 0389-2015-0024 и частично поддержана Комплексной программой фундаментальных научных исследований УрО РАН на 2018-2020г.г. (проект № 18-2-2-1).

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. *Tishin A.M., Spichkin Y.I.* The magnetocaloric effect and its applications. Bristol. IOP Publishing, 2003. 465 p.
- Gschneider K.A., Jr, Pecharsky V.K., Tsokol A.O. Recent developments in magnetocaloric materials // Rep. Progr. Phys. 2005. V. 68. P. 1479–1539.

- de Oliveira N.A., von Range P.J. Theoretical aspects of the magnetocaloric effect // Physics Reports. 2010. V. 489. P. 89–159.
- Ram N.R., Prakash M., Naresh U., Kumar N.S., Sarmash T.S., Subbarao T., Kumar R.J., Kumar G.R., Naidu K.C.B. Review on magenocaloric effect and materials // J. Superconductivity and Novel Magnetism. 2018. V. 31. P. 1971–1979.
- 5. Вонсовский С.В. Магнетизм. М.: Наука, 1971. 1032 с.
- Кокорина Е.Е., Медведев М.В. Обратный магнитокалорический эффект в одноосном парамагнетике с некрамерсовыми ионами // ФММ. 2017. Т. 118. В. 3. С. 230–239.
- Онуфриева Ф.П. Аномалии магнитных свойств ферромагнетика с одноионной анизотропией // ФТТ. 1984. Т. 26. V. 11. С. 3435–3437.